

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		

A4			ТЭСМ.505010 ПЭЗ	Перечень элементов		
A3			ТЭСМ.505010 СБ	Сборочный чертеж		
A4			ТЭСМ.505010 ЭЗ	Схема электрическая		
				принципиальная		
				ДЕТАЛИ		

		1	ТЭСМ.507301v02	Плата печатная контроллера		
				дисплея	1	
				ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		

				ДЖАМПЕРЫ		
		13		Вилка PLS-2	2	JP3, JP5
				КОНДЕНСАТОРЫ		
		22		B45196-H1106-M106 Size A 10 мкФ		
				±20% 6.3V Epcos, KEMET, AVX		
				(B45196-H2106-M106 Size A 10		
				мкФ ±20% 6.3V Epcos,		
				B45196-H2106-K106 Size A 10 мкФ		
				±10% 6.3V Epcos,		
				B45196-H2106-J106 Size A 10 мкФ		
				±5% 6.3V Epcos	7	C25, C44, C45
						C47, C53, C59
						C72
4		РМ 1685		14.10.2011	ТЭСМ.505010	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Макарова			14.10.2011	Контроллер дисплея МПР5-02, МПР6-03	
Пров.	Ошеев					
Т. контр.	Алешкевич					
Н. контр.	Макарова					
Утв.	Булаев					
						ТЭСМ.506103
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
						Перв. прим.

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.		
		31		Ионистор EECF5R5U105 1 F 5.5V				
				20x6 Gold Capacitor Series	1	C16		
		37		Керам. ЧИП конд. 20 пФ ±5% 0805				
				NPO	2	C111, C114		
		46		Керам. ЧИП конд. 330 пФ ±5%				
				0603 NPO	4	C4, C6 .. C8		
		52		Керам. ЧИП конд. 0.022 мкФ ±5%				
				0805 NPO C5437 CVNF022K0805				
				SCHUKAT	2	C67, C69		
				МИКРОСХЕМЫ АНАЛОГОВЫЕ				
		58		ADM706RAR SOIC-8 Analog Devices				
				DS ADM705-ADM708 rev.A 1996	1	DA2		
		61		CP2200-GQ TQFP-48 Silicon				
				Laboratories Inc.	1	DA4		
		64		LM1117DT-3.3 TO-252 National				
				Semiconductor	1	DA5		
		67		LM1117MP-2.5 SOT223 National				
				Semiconductor	1	DA3		
		70		TPS70102PWP PWP PSOP-20 TI DS				
				TPS701xx rev.03/2000	1	DA1		
				МИКРОСХЕМЫ ЦИФРОВЫЕ				
		76		74LVC1G32DBV SOT-23-5L TI	1	DD1		
				ТЭСМ.505010			Лист	
								2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.				Дата	
Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
							Подп. и дата	

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		79		AT91R40008 TQFP-100 Atmel	1	DD2
		82		DS1302Z SOIC-8 DALLAS		
				Semiconductor DS DS1302		
				rev.032598 1/12	1	DD6
		85		EP3C5F256C8N FBGA-256 Altera	1	DD3
		88		MC74VHC1GT08DTT1 SOT23-5L ON		
				Semiconductor	1	DD5
		94		TSC2046IPW TSSOP-16 TI	1	DD7
				РАЗЪЕМЫ		
		100		Вилка ВН-16 (IDC-16М вилка на		
				плату)	1	XP4
		103		Вилка PLD-10	1	XP2
		112		Вилка PLD2-24	1	XP1
		115		Вилка IDC2-24М	1	XP3
		121		Вилка PLS-4	1	XP9
		123		Розетка 500873-0806 Molex	1	XP11
						(доп. замена на
						XP8 по указ.)

<i>Ф-т</i>	<i>Зо на</i>	<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Прим.</i>
				РЕЗОНАТОРЫ		
		166		GXO-U108L 30 МГц Golledge DS SM		
				Oscillator GXO-U108 rev.03/2000		
				(O-VX3MH 30 МГц)	1	BQ2
		172		HC49SD-20-C-30-30-F 20 МГц		
				Vanlong Technology Co. Ltd.	1	BQ6
		178		Кварцевый 32768 Гц столб. 2х6мм		
				DT-26T, столб. 3х8мм DT-38T		
				Промэлектроника	1	BQ3
						(доп. замена на
						BQ4 по указ.)
		179		Q 0.032768-SM26F-12.5-20 typeB		
				0.032 МГц ±20% Jauch DS Jauch		
				Quartz GmbH rev02/2004	1	BQ4
						(вместо BQ3 по
						указ.)
				ТРАНСФОРМАТОРЫ		
		184		20F001N Sun Muung Корея (FC-22,		
				Ремкомплект датчика SpO2		
				U400-AF-E Unimed China)	1	TV1
				МИКРОСХЕМЫ ЦИФРОВЫЕ		
		187		AM29LV160DB-70EC TSOP-48 AMD	1	DS1
					<i>ТЭСМ.505010</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		
<i>Инв. № подл.</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>
						<i>Подп. и дата</i>

[illegible]

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Переменные данные для		
				исполнений:		
				ТЭСМ.505010		
				полный вариант		

				ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		

				ИНДУКТИВНОСТИ		
		16		BLM21AH102SN1D 0805 Murata	4	L4 .. L6, L8
		19		BLM21PG221SN1D 0805 Murata	5	L1 .. L3, L7, L9
				КОНДЕНСАТОРЫ		
		25		B45196-H4106-M206 Size B 10		
				мкФ ±20% 20V Epcos	9	C1, C2, C9 .. C13
						C88, C90
		28		NFA31GD1004704 10 pF ±20% 6V		
				3.2x1.6mm NFA31GD1004704		
				10pF ±20% 47Om ±30% Murata	9	C14, C15, C17
						C60 .. C64, C115
		34		Керам. ЧИП конд. 10 пФ ±5% 50B		
				0603 NPO	3	C93 .. C95
		40		Керам. ЧИП конд. 47 пФ ±5% 0603		
				NPO	2	C96, C97
		43		Керам. ЧИП конд. 100 пФ ±5%		
				0603 NPO	4	C3, C5, C74, C76
				ТЭСМ.505010		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.			
						Лист
						7
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.	
		49		Керам. ЧИП конд. 1000 пФ ±10%			
				16В 0402 Х7R	3	C20, C23, C92	
		55		Керам. ЧИП конд. 0.1 мкФ ±20%			
				16В 0402 Y5V	54	C18, C19, C21	
						C22, C24	
						C26 .. C43	
						C48 .. C50, C52	
						C54 .. C58, C65	
						C66, C68, C70	
						C71, C73, C75	
						C77 .. C87, C89	
						C91, C98, C99	
				МИКРОСХЕМЫ АНАЛОГОВЫЕ			
		73		VNC1L LQFP-48 Future Technology			
				Devices International	1	DA6	
				МИКРОСХЕМЫ ЦИФРОВЫЕ			
		91		PCA82C250T SOIC-8 Philips	1	DD4	
				РАЗЪЁМЫ			
		97		Вилка В4В-РН-К-S	2	XP6, XP10	
		109		Вилка PLD2-18	1	XP17	
				РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ			
		133		CR0603-JW-102 1 кОм ±5% 0603			
				BOURNS	2	R25, R51	
		139		CR0805-JW-121E 120 Ом ±5% 0805			
				BOURNS (PH1-12 0.125 120 Ом ±5%			
				0805)	1	R28	
				ТЭСМ.505010			Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.				Дата
Инв. № подл.			Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				ТЭСМ.505010-01		
				МПР6-03 12", 15"		

				ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		

				ИНДУКТИВНОСТИ		
		16		BLM21AH102SN1D 0805 Murata	2	L4, L5
		19		BLM21PG221SN1D 0805 Murata	2	L1, L9
				КОНДЕНСАТОРЫ		
		25		B45196-H4106-M206 Size B 10		
				мкФ ±20% 20V Epcos	7	C2, C9 .. C13
						C88
		28		NFA31GD1004704 10 pF ±20% 6V		
				3.2x1.6mm NFA31GD1004704		
				10pF+-20% 47Om+-30% Murata	3	C14, C15, C17
		49		Керам. ЧИП конд. 1000 пФ ±10%		
				16B 0402 X7R	2	C20, C23
		55		Керам. ЧИП конд. 0.1 мкФ ±20%		
				16B 0402 Y5V	51	C18, C19, C21
						C22, C24
						C26 .. C43
						C48 .. C50, C52
						C54 .. C58, C65
						C66, C68, C70
						C73, C75
						C77 .. C87, C98
						C99
				ТЭСМ.505010		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
						Лист
						10
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Ф-т	Зо на	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				ТЭСМ.505010-02 сокращенный		
				вариант МПР5-02 7"+TS		

				ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ		

				ИНДУКТИВНОСТИ		
		16		BLM21AH102SN1D 0805 Murata	2	L4, L5
		19		BLM21PG221SN1D 0805 Murata	2	L1, L9
				КОНДЕНСАТОРЫ		
		25		B45196-H4106-M206 Size B		
				10мкФ ±20% 20V Epcos	7	C2, C9 .. C13
						C88
		28		NFA31GD1004704 10 pF ±20% 6V		
				3.2x1.6mm NFA31GD1004704		
				10pF ±20% 47Om ±30% Murata	9	C14, C15, C17
						C60 .. C64, C115
		49		Керам. ЧИП конд. 1000 пФ ±10%		
				16B 0402 X7R	2	C20, C23
		55		Керам. ЧИП конд. 0.1 мкФ ±20%		
				16B 0402 Y5V	51	C18, C19, C21,
						C22, C24
						C26 .. C43
						C48 .. C50, C52
						C54 .. C58, C65
						C66, C68, C70, C73
						C75, C77 .. C87
						C98, C99
				ТЭСМ.505010		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.			Подп. и дата			
			Взам. инв. №			
			Инв. № дубл.			
					Подп. и дата	

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

					ТЭСМ.505010	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №	Инв. № дубл.
						Подп. и дата